

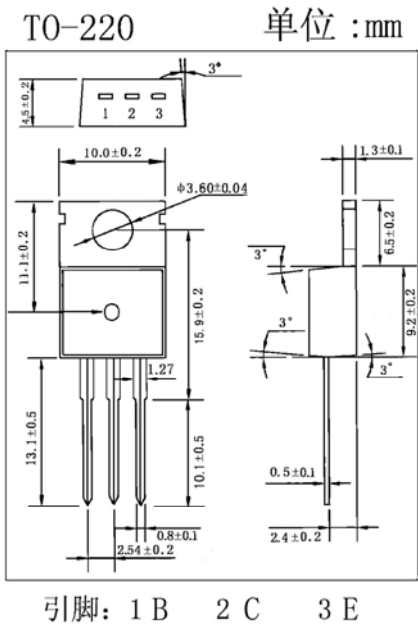
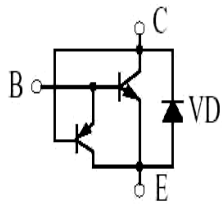
MJE13005VT7 (3DD13005VT7) 硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于高频电子照明电路、开关及开关电源。

Purpose: High frequency electronic lighting, switching power supply applications.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	400	V
V_{CE0}	200	V
V_{EB0}	9.0	V
I_C	8.0	A
$P_C(Ta=25^{\circ}C)$	2.0	W
$P_C(Tc=25^{\circ}C)$	75	W
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=1mA$	$I_E=0$	400			V
V_{CE0}	$I_C=10mA$	$I_B=0$	200			V
V_{EB0}	$I_E=1mA$	$I_C=0$	9.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=400V$	$I_E=0$			0.1	mA
I_{CE0}	$V_{CE}=200V$	$I_B=0$			0.1	mA
I_{EB0}	$V_{EB}=9.0V$	$I_C=0$			0.1	mA
h_{FE}	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=1.0A$	10		40	
$V_{CE(sat)}(1)$	$I_C=2.0A$	$I_B=0.5A$			0.6	V
$V_{CE(sat)}(2)$	$I_C=4.0A$	$I_B=1.0A$			0.8	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.0A$	$I_B=0.5A$			1.2	V
f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.5A$ $f=1MHz$		4.0			MHz
t_f	$V_{CE}=5V$ $I_C=0.5A$ (UI9600)				0.6	μs
t_s					4.0	μs

MJE13005VT7 (3DD13005VT7)

